


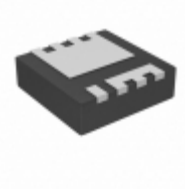






	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ058N03MSGATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>
	<p>Datenblätter:  BSZ058N03MSGATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	BSZ058N03MSGATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	2.1W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3100pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Ta), 40A (Tc)

BSZ058N03MSGATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ058N03MSGATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ058N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ058N03MSGATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ065N03LS Infineon Technologies BSZ065N03LS Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ065N03LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 12A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ058N03MS G INFINEON BSZ058N03MS G INFINEON</p>	 <p>BSZ058N03MSG QFN8 INFINEON BSZ058N03MSG QFN8 INFINEON</p>
 <p>BSZ058N03LSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 40A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ060NE2LS Infineon Technologies BSZ060NE2LS Infineon Technologies</p>	 <p>BSZ060NE2LSATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 12A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ058N03M Infineon Infineon QFN8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ058N03MSGATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ058N03MSGATMA1 Datenblatt	BSZ058N03MSGATMA1-Datenblätter	BSZ058N03MSGATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ058N03MSGATMA1
BSZ058N03MSGATMA1 Electronic	BSZ058N03MSGATMA1-Komponenten	BSZ058N03MSGATMA1-Verteiler	BSZ058N03MSGATMA1-Bild	BSZ058N03MSGATMA1-Teil
BSZ058N03MSGATMA1 Preis	BSZ058N03MSGATMA1 Hersteller	BSZ058N03MSGATMA1 Bild	BSZ058N03MSGATMA1 Aktie	BSZ058N03MSGATMA1 Inventar
BSZ058N03MSGATMA1 Neu	BSZ058N03MSGATMA1 Original	BSZ058N03MSGATMA1 garantiert	BSZ058N03MSGATMA1 RFQ	BSZ058N03MSGATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited